高精度实时时钟－SD2501

内置晶振、NVSRAM、温度补偿、电池电量监测、IIC 串行接口、多种中断输出、高精度

1. 概述

SD2501 系列是一种具有内置晶振、NVSRAM、IIC 串行接口的高精度实时时钟模块，CPU 可使用该接口通过 7 位地址来寻址读写片内 122 字节的数据(包括时间寄存器、报警寄存器、控制寄存器、温度寄存器、电池电量寄存器、70 字节的用户 SRAM 寄存器及 8 字节的 ID 码寄存器)。

SD2501 系列模块内置晶振及数字温度补偿，用户可以不用顾虑因外接晶振、谐振电容等所带来的元件匹配误差问题、晶振温度特性问题及可靠性问题，实现在常温及宽温范围内不需用户干预、全自动、高可靠计时功能;SD2501 可保证时钟精度为±5ppm(在 25℃左右)，即年误差小于 2.6 分钟；该模块内置充电电池,电池使用寿命五~八年时间。

SD2501 系列内置 8 字节的 ID，每一颗模块具备唯一的身份识别码。

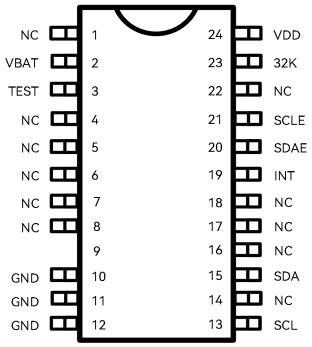
SD2501 系列模块内置单路定时/报警中断输出,报警中断时间可最长设至 100 年;该系列模块可满足对实时时钟模块的各种需要，有工业级产品可供选择，且软件和管脚与以前的 SD2400RAM 兼容**(重要区别在：强烈建议用户的程序在每一次上电时重置 18H 寄存器的值为 82H，用于确保开启充电功能)**,是在选用高精度实时时钟时的理想选择。

2. 主要性能特点：

- 低功耗：典型值0.7μA（VBAT=3.0V,Ta=25℃）。
- 工作电压：3.3V～5.5V,工作温度：－30℃～+80℃。
- 标准IIC总线接口方式,最高速度400kHz。
- 年、月、日、星期、时、分、秒的BCD码输入/输出,并可通过独立的地址访问各时间寄存器。
- 闰年自动调整功能(从2000年~2099年)。
- 可选择12/24小时制式。
- 5种中断均可选择从INT脚输出,并具有4个中断标志位.
- 内置年、月、日、星期、时、分、秒共7字节的报警数据寄存器及1字节的报警允许寄存器，共有96种组合报警方式，并有单事件报警和周期性报警两种中断输出模式，报警时间最长可设至100年。
- 周期性频率中断输出:从4096Hz～1/16Hz……1秒共十四种方波脉冲。
- 自动重置的三字节共24位的倒计时定时器,可选的2种时钟源（4096Hz、1024Hz）。
- 70Bytes通用SRAM寄存器可用于存储用户的一般数据。
- 内置16kbit～512kbit的非易失性SRAM(C/D/E/G型)，其擦写次数100亿次，且没有内部写延时。
- 内置充电电池及充电电路，累计电池电量超过550mAH,在电池满充的常温情况下内部时钟走时时间在一年左右，电池使用寿命为5～8年时间。

- 内置电池电压检测功能，可读取当前电池电压值(三位有效数)，设置高低电池报警电压值并从INT脚输出中断。
- 后备电池输入脚VBAT:当内部电池因寿命等原因报废时,可用外加的电池给时钟作备电。
- 具有可控的32768Hz方波输出脚F32K，可以位允许/禁止32K输出
- 内置8bit转换结果的数字温度传感器，为了节省电池电量消耗，设为VDD模式下60S间隔测温一次，电池模式600S间隔测温一次。
- 内置晶振和谐振电容，模块内部通过高精度补偿方法，实现在宽温范围内高精度的计时功能，其中25℃精度<±5ppm，即时钟年误差小于2.6分钟(在25±1℃下)。
- 模块依据不同的电压自动从VDD切换到VBAT或从VBAT切换到VDD。当模块检测到主电源VDD掉到2.4V电压以下且VDD小于VBAT,模块会转为由接在VBAT的后备电池供电；当VDD大于VBAT或VDD大于2.4V,则模块会转为由VDD供电。（内置电源模式指示位PMF,VDD模式时PMF=0，VBAT模式时PMF=1）。
- 内置8字节的ID码，模块出厂之前设定的、全球唯一的身份识别码。
- 内置IIC总线0.5秒自动复位功能(从Start命令开始计时),该功能可以避免IIC总线挂死问题。
- 内置三个时钟数据写保护位，避免对数据的误写操作，可更好地保护数据。
- 内置软件可控VBAT模式IIC总线通信禁止功能（BATIIC=0，VBAT模式下禁止IIC通信；BATIIC=1,VBAT模式下允许IIC通信，上电默认值BATIIC=0),从而避免在电池供电时CPU对时钟操作所消耗的电池电量，也可避免在VDD上、下电的过程中因CPU的I/O端口所输出的不受控的杂波信号对时钟模块的误写操作，进一步提高时钟模块的可靠性。
- 内置上电复位电路及上电指示位RTCF,当包括电池在内的所有电源第一次上电时该位置1。
- 内置电池电压欠压指示位BLF，当电池电压低于2.2V时BLF位置1。
- 内置停振检测位OSF,当内部振荡器停止振荡时该位置1。
- 内置电源稳压,内部计时电压可低至1.8V。
- 模块管脚 ESD>2KV。
- 模块在兴威帆的评估板上可通过4KV的群脉冲(EFT)干扰。
- CMOS 工艺
- 有工业级型号，其尾缀加“I”以示区分，如“SD2501API”为SD2501AP的工业级，“P”标志为直插封装形式。

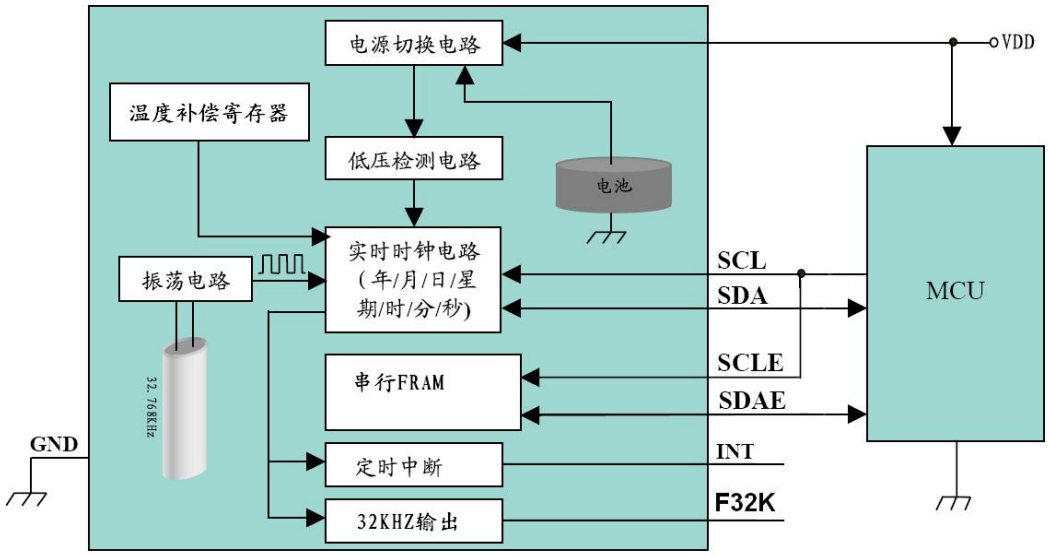
3. 管脚设置和原理框图



SD2501 系列模块管脚图

SD2501 系列管脚功能表

标号	功能	特征
V_{BAT}	外加备用电池引脚	针对 SD2501 系列，由于在模块内部有电池，故在其电池电量未耗尽之前可不接。
TEST	测试	内部电池电压检测脚（通常不接）
SCL	串行时钟输入脚，由于在 SCL 上升/下降沿处理信号，要特别注意 SCL 信号的上升/下降升降时间，应严格遵守说明书。	CMOS 输入
SDA	串行数据输入/输出脚，此管脚通常用一电阻上拉至 VDD，并与其它漏极开路或集电器开路输出的器件通过线与方式连接。	N 沟道开路输出，CMOS 输入。
INT	报警中断输出脚，根据中断寄存器与状态寄存器来设置其工作的模式，当定时时间到达时输出低电平或时钟信号。它可通过重写状态寄存器来禁止。	N-沟道开路输出
SCLE	NVSRAM 串行时钟输入脚，由于是在 SCLE 时钟输入信号的上升边缘和下降边缘来进行。因此请注意上升和下降时间，并遵守技术规范。	CMOS 输入。
SDAE	NVSRAM 串行数据输入/输出脚，此管脚通常用一电阻上拉至 VDD，并与其它漏极开路或集电器开路输出的器件通过“或”方式连接。	N 沟道开路输出。
F32K	32KHz 频率输出脚	开漏输出
VDD	正电源	
GND	负电源	



SD2501 系列功能框图

注：图中 SDA、SCL、SDAE、SCLE、INT、F32K 对 VDD 上拉电阻均未标出，实际应用中要加上。

4. 基本功能定义

4.1 寄存器列表

地址	寄存器段	寄存器名称	BIT								数值范围（十进制）	复位值（二进制）
			D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
00H	实时时钟寄存器	秒	0	S40	S20	S10	S8	S4	S2	S1	0-59	XXXX-XXXX
01H		分钟	0	MN40	MN20	MN10	MN8	MN4	MN2	MN1	0-59	XXXX-XXXX
02H		小时	12_/24	0	H20P/A_	H10	H8	H4	H2	H1	0-23	XXXX-XXXX
03H		星期	0	0	0	0	0	W4	W2	W1	0-6	XXXX-XXXX
04H		日	0	0	D20	D10	D8	D4	D2	D1	1-31	XXXX-XXXX
05H		月	0	0	0	MO10	MO8	MO4	MO2	MO1	1-12	XXXX-XXXX
06H		年	Y80	Y40	Y20	Y10	Y8	Y4	Y2	Y1	0-99	XXXX-XXXX
07H	时间报警寄存器	秒报警	0	AS40	AS20	AS10	AS8	AS4	AS2	AS1	0-59	0000-0000
08H		分钟报警	0	AMN40	AMN20	AMN10	AMN8	AMN4	AMN2	AMN1	0-59	0000-0000
09H		小时报警	0	0	AH20 AP/A_	AH10	AH8	AH4	AH2	AH1	0-23	0000-0000
0AH		星期报警	0	AW6	AW5	AW4	AW3	AW2	AW1	AW0	N/A	0000-0000
0BH		日报警	0	0	AD20	AD10	AD8	AD4	AD2	AD1	1-31	0000-0000
0CH		月报警	0	0	0	AMO10	AMO8	AMO4	AMO2	AMO1	1-12	0000-0000
0DH		年报警	AY7	AY6	AY5	AY4	AY3	AY2	AY1	AY0	0-99	0000-0000
0EH		报警允许	0	EAY	EAMO	EAD	EAW	EAH	EAMN	EAS	N/A	0000-0000
0FH	控制寄存器	CTR1	WRTC3	OSF	INTAF	INTDF	BLF	WRTC2	PMF	RTCF	N/A	0000-0000
10H		CTR2	WRTC1	IM	INTS1	INTS0	FOBAT	INTDE	INTAE	INTFE	N/A	0000-0000
11H		CTR3	ARST	F32K	TDS1	TDS0	FS3	FS2	FS1	FS0	N/A	0000-0000

12H		25℃CTTF（只读 RAM）	1ppm/3ppm	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F0	N/A	0000-0000
13H		倒计时定时器	TD7	TD6	TD5	TD4	TD3	TD2	TD1	TD0	0-255	0000-0000
14H			TD15	TD14	TD13	TD12	TD11	TD10	TD9	TD8	0-255	0000-0000
15H			TD23	TD22	TD21	TD20	TD19	TD18	TD17	TD16	0-255	0000-0000
16H	未开放	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-255	xxxx-xxxx
17H	IIC 控制寄存器	AGTC	BATIIC	0	BSY	CONT	-	-	-	-	0-255	0000-0000
18H	充电寄存器	CHARGE	ENCH	-	-	-	-	-	Charge1	Charge0	0-255	0000-0000
19H	扩展控制寄存器	CTR4	INTS_E2	INTS_E1	INTS_E0	CONT_BAT	INTTHE	INTTLE	INTBHE	INTBLE	0-255	0000_0000
1AH		CTR5	BAT8_VAL	SYS	OSC_RDY				BHF	BLF	0-255	0000_0000
1BH	电池电量	BAT_VAL	BAT7_VAL	BAT6_VAL	BAT5_VAL	BAT4_VAL	BAT3_VAL	BAT2_VAL	BAT1_VAL	BAT0_VAL	0-255	0000_0000
1CH~2BH	未开放	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	xxxx_xxxx
2CH~71H	用户 RAM	(70bytes)	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0		XXXX-XXXX
72H~79H	ID(只读)	(8Bytes)	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	N/A	XXXX-XXXX

注：“X”表示随机值，可以为 0 或者 1。

4.2 实时时钟数据寄存器(00H~06H)

实时时钟数据寄存器是 7 字节的存储器，它以 BCD 码方式存贮包括年、月、日、星期、时、分、秒的数据。

年数据[06H 地址]（00~99）：设置千年（20XX）的后两位数字（00~99），通过自动日历功能计至 2099 年。（注意：2000 年为闰年）

月数据[05H 地址（01~12）：每月包含的天数通过自动日历功能来更改。

1,3,5,7,8,10,12：1~31

4,6,9,11：1~30

2(闰年)：1~29

2(普通)：1~28

日数据[04H 地址]（01~31）

星期数据[03H 地址]（00~06）：七进制计数器,00 对应星期天,01 对应星期一,依次类推。

小时数据[02H 地址]（00~23 或 01~12）：小时的最高位 12_/24 是 12 或 24 小时制选择位。

当 12_/24=1 时,24 小时制；当 12_/24=0 时， 12 小时制。

12 小时制时,H20 为 AM/PM 指示位,H20=0 为 AM,H20=1 为 PM,

见下表:(位 H20H10H8H4H2H1)

24 小时显示系统	12 小时显示系统	24 小时显示系统	12 小时显示系统
00	12（AM12）	12	32（PM12）
01	01（AM1）	13	21（PM1）
02	02（AM2）	14	22（PM2）
03	03（AM3）	15	23（PM3）
04	04（AM4）	16	24（PM4）
05	05（AM5）	17	25（PM5）
06	06（AM6）	18	26（PM6）
07	07（AM7）	19	27（PM7）
08	08（AM8）	20	28（PM8）
09	09（AM9）	21	29（PM9）
10	10（AM10）	22	30（PM10）
11	11（AM11）	23	31（PM11）

注意：当读取小时数据时,要屏蔽掉小时的最高位 12_/24,否则在 24 小时制时会因为 12_/24=1 而显示不对。

分数据[01H 地址]（00~59）

秒数据[00H 地址]（00~59

例如:设置时间为2006年12月20日星期三18点19分20秒(24小时制),则寄存器00～07H的赋值应分别为20h、19h、98h、03h、20h、12h、06h。要特别注意此处小时位的赋值,因为是24小时制式,小时的12_/24位=1,所以小时的赋值为98h(1001 1000B)。
也请注意在24小时制时,当小时数据读出后,其最高位为1,所以要将读到的数据最高位置0,否则小时数据不对。

注:

1.在上电复位时，模块内部不对实时时钟数据寄存器作清零或置位处理。

2.当写实时时间数据时(00H~06H),不可以单独对7个时间数据中的某一位进行写操作,否则可能会引起时间数据的错误进位,所以要修改其中某一个数据，应一次性写入全部7个实时时钟数据。

3. 当模块收到读实时时钟数据命令,则所有实时时钟数据被锁存（时钟走时并不受影响）,此功能可以避免时间数据的错读现象。

4.3 时间中断(07H~15H 地址)

SD2501有3种不同时间报警中断,它们由控制寄存器CTR2(10H)中的位INTAE、INTFE、INTDE位来使能:

中断允许位/标志位列表

序号	中断允许位 (1=允许,0=禁止)	中断名	中断标志位 (1=有中断,0=无中断)
1	INTAE	报警中断	INTAF
2	INTFE	频率中断	无
3	INTDE	倒计时中断	INTDF

当报警中断产生时,置中断标志位 INTAF 为 1;当倒计时中断产生时, 置中断标志位 INTDF 为 1;频率中断没有标志位，标志位被置 1 后,需要手动清除。

三种中断都是以 INT 脚为输出脚, 通过控制寄存器 2 中的 INTS1、INTS0 位来选择确定 INT 脚输出何种中断:

INT 脚中断输出选通表

序号	INTS1	INTS0	描述
0	0	0	电量报警（见 4.4）
1	0	1	报警中断输出
2	1	0	频率中断输出
3	1	1	倒计时中断输出

（1）报警中断

当 INTAE=1 时报警中断被允许,报警中断何时发生由时间报警寄存器(07H~0EH)来确定。这其中 07H~0DH 依次用于存放报警时间的秒、分钟、小时、星期、日、月、年数据,除小时报警数据寄存器的最高位始终为”0” 、星期位的定义不同以外，其它的格式与实时时钟寄存器相同。

0EH 为时间报警允许寄存器,如下:

BIT	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
位名(值)	0	EAY	EAMO	EAD	EAW	EAH	EAMN	EAS
报警允许	-	年 (0DH)	月 (0CH)	日 (0BH)	星期 (0AH)	小时 (09H)	分钟 (08H)	秒 (07H)

注:1=允许,0=禁止。

时间报警允许寄存器的使能位是用于确定哪些时间报警寄存器(秒、分钟等)需要与实时时钟寄存器之间作比较。当实时时钟运行时,一旦被允许的报警寄存器均与对应的实时时钟寄存器相匹配，就会触发一次报警中断,同时报警中断标志位 INTAF 位被置”1”。

特别：

1.当日报警与星期报警均被允许即 EAD=EAW=1 时，只有日报警有效,而星期报警无效，所以时间报警中断共有 96 种组合方式。

2.星期报警寄存器的数据格式与实时时钟数据星期的格式不同,星期报警寄存器的位 AW6、AW5、AW4、AW3、AW2、AW1、AW0 分别对应星期六、星期五、星期四、星期三、星期二、星期一、星期日,并可多位置 1,例如 AW6,AW1=1,其它位为 0,则对应在星期六，星期一会有报警。

每一次对时间报警允许寄存器的写入都会清 INTAF 为"0"，当设置 INTS1=0、INTS0=1 时,即允许报警中断从 INT 脚输出。该报警中断有两种模式,即单事件报警和周期性报警, 模

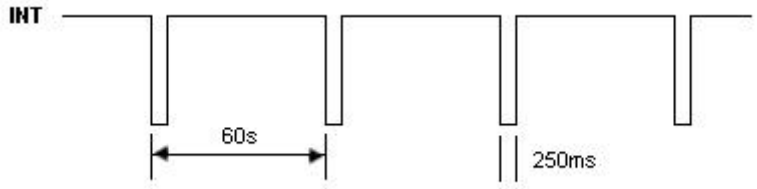
式的选定由控制寄存器 2 中的报警中断模式位 IM 的值来定:

IM 位	报警中断模式	INT 脚
0	单事件报警	输出低电平直至 INTAF 位清零
1	周期性报警	输出低电平有效、宽度为 250ms 的周期性脉冲直至中断允许位清零

为清除报警中断,可通过写操作将控制寄存器 1 的 INTAF 位置”0”，但当 ARST 位置为”1”,则在控制寄存器 1 被读取时,INTAF 位会自动清零。

举例:

1. 设寄存器 0EH=00000001B,秒报警寄存器 07H=20h,位 INTAE=1、IM=1、INTS1=0、INTS0=1 ,则每当时间秒数据进位到 20h 的时候，INT 脚都会输出宽度为 250ms 的低电平,即频率为 1 分钟的方波。如下图：



2. 设寄存器 0EH=00001111B,星期报警寄存器 0AH=0010 0110B,小时报警寄存器 09H=08h,分钟报警寄存器 08H=30h,秒报警寄存器 07H=00h,位 INTAE=1、IM=1、INTS1=0、INTS0=1 ， 则每到星期一、星期二、星期五的 8 点 30 分 0 秒的时候，INT 脚都会输出宽度为 250ms 的低电平。

3. 设寄存器 0EH=00010111B,日报警寄存器 0BH=01h,小时报警寄存器 09H=08h,分钟报警寄存器 08H=30h,秒报警寄存器 07H=00h,位 INTAE=1、IM=1、INTS1=0、INTS0=1 ， 则到每个月 1 号的 8 点 30 分 0 秒的时候，INT 脚都会输出宽度为 250ms 的低电平。

4. 设寄存器 0EH=0111 0100B， 年报警寄存器 0DH=08h,月报警寄存器 0CH=08h,日报警寄存器 0BH=08h,小时报警寄存器 09H=20h,位 INTAE=1、IM=0、INTS1=0、INTS0=1、12_/24=1 ,则到 2008 年 8 月 8 日 20 点 0 分 0 秒时，INT 脚会输出低电平。此后如清零 INTAF，则 INT 脚从低电平变成高电平。

（2）频率中断

当 INTFE=1 时频率中断被允许， INTFE=0 时频率中断被禁止。

当设置 INTS1=1、INTS0=0 时,即允许频率中断从 INT 脚输出，频率中断没有标志位。

INT 脚输出频率中断由控制寄存器 3 中的 FS3、FS2、FS1、FS0 位来选择确定:

频率(Hz)	FS3	FS2	FS1	FS0
0	0	0	0	0
4096	0	0	1	0
1024	0	0	1	1
64	0	1	0	0
32	0	1	0	1
16	0	1	1	0
8	0	1	1	1
4	1	0	0	0
2	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1/2	1	0	1	1
1/4	1	1	0	0
1/8	1	1	0	1
1/16	1	1	1	0
1 秒	1	1	1	1

注:除了 1 秒外,INT 脚输出的频率中断均是由 32768Hz 晶体振荡电路整形及分频得到的;1 秒频率中断是指输出 500ms 低电平、500ms 高电平的方波,其低电平的下降沿与秒进位同步; 在温度补偿时内部数字调整寄存器起作用时,1 秒和 1Hz 的时长是不相同的。

例如:需要 INT 脚输出 1Hz 信号时,可以通过设置位 INTS1=1、INTS0=0、INTFE=1、FS3-FS2-FS1-FS0=1010 得到。

（1）倒计时中断

与倒计时中断相关的寄存器是三字节 24bit 的倒数定时器 13H、14H 和 15H, 当控制寄存器 CTR2 中的位 INTDE=1 时倒计时中断被允许。

倒数定时器的频率源由控制寄存器 CTR2 中的位 TDS1、TDS0 来选定;

TDS1	TDS0	定时器频率源
0	0	4096Hz
0	1	1024Hz

当 INTDE=1 且倒数定时器写入一个 24 位自动重置的二进制数后, 倒数定时器会按照 TDS1、TDS0 选定的频率时间来减一.每次当三字节倒数定时器全为零时,会置倒计时中断的标志位(控制寄存器 1 中的位 INTDF)为 1。

当设置 INTS1=1、INTS0=1、IM=0 时,即允许倒计时中断的低电平从 INT 脚输出. 置 INTDF=0 时 INT 脚输出变为高电平直到下一次倒计时中断 INT 脚再次变为低电平;当设置 INTS1=1、INTS0=1、IM=1 且倒数定时周期大于 250ms 时,则从 INT 脚输出低电平时间为 250ms 连续脉冲。

当设置 INTDE=0 时倒计时中断被禁止或复位。

特别的:当重新配置倒计时中断时,需要复位倒计时计数器,即置 INTDE=0,然后再置 INTDE=1,才可以启用新的倒计时中断。

4.4 电池控制寄存器

4.4.1 IIC 控制寄存器 AGTC（17H）

BATIIC: BATIIC=0，VBAT 模式下禁止 IIC 通信;BATIIC=1，VBAT 模式下允许 IIC 通信,该寄存器位上电默认值为 0。

4.4.2 扩展控制寄存器 CRT4(19H):

名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	复位值
CTR4	INTS_E2	INTS_E1	INTS_E0	CONT_BAT	INTTHE	INTTLE	INTBHE	INTBLE	0000_0000

当寄存器 10H 中的{INTS1,INTS0}=00 时，INT 引脚输出扩展以下功能：

INTS_E2	INTS_E1	INTS_E0	功能描述
0	0	0	禁止输出,高阻态
0	0	1	-
0	1	0	-
0	1	1	电池低压报警
1	0	0	电池高压报警
其他			禁止输出,高阻态

CONT_BAT：电池电量强制测量位。

置该位为 1 时将强制模块进行一次电池电量的测量。测量时 BSY 为 1，测量结束后，CONT_BAT 和 BSY 自动变为 0；测量结果存放在寄存器 1AH[7]和 VBAT_VAL 中。

注：VDD 模式下，模块电池电量测量周期为 60S，从每分钟的第 3S 开始测量；VBAT 模式下，模块电池电量测量周期为 600S，从分钟的个位为 0 的第 3S 开始测量。

INTTHE： 固定设置为 0

INTTLE： 固定设置为 0

INTBHE：电池高压报警使能位 （报警电压值电压值为 3.30V，精度±0.10V），当若 INTBHE=1 且检测到的 VBAT 脚电压大于等于 3.3V 时置 INTBHE 位为 1。

INTBLE：电池低压报警使能位（电池报警电压值为 2.20V，精度±0.10V），当若 INTBLE=1 且检测到的 VBAT 脚电压小于等于 2.2V 时置 INTBLE 位为 1。

注：以上两种报警中断均只支持单周期报警中断，不支持周期性报警中断。

4.4.3 寄存器 CTR5(1AH)

名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	复位值
CTR5	BAT8_VAL	-	-	-	-	-	BHF	BLF	0000_0000

BAT8_VAL：电池测量结果的最高位

BHF：电池电压高压标志位

BLF：电池电压欠压标志位（与 0FH 寄存器的 BLF 位完全相同，为方便读电池状态而设置）。

BHF、BLF 不能通过软件来设置或清除；当 INT 选择为 BHF、BLF 输出时，中断脚 INT 的状态和 BHF、BLF 状态一致。

4.4.4 电池电量低八位寄存器（1BH）

名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	复位值
BAT_VL	BAT7_VL	BAT6_VL	BAT5_VL	BAT4_VL	BAT3_VL	BAT2_VL	BAT1_VL	BAT0_VL	0000_0000

电池测量值，若禁止电池测量，则读出的数据为 0，该寄存器只读。

1AH[7]即 BAT8_VAL 与 1BH 合起来的 9 位数据的表示电池电量的电压值。

如 1AH[7]=1,VBAT_VAL=35H,则当前所测的电池电量=135H=309（十进制）=3.09V。

4.5 用户 RAM(2CH~71H):70 字节的用户数据 RAM

4.6 ID 码（72H~79H）：八字节的模块身份识别码，包含生产日期、内部批号、内部序号等等

ID 码地址	72H	73H	74H	75H	76H	77H	78H	79H
说 明	生产年份：00~99	生产月份：1~12	生产日份：1~31	生产机台编号	四位生产工单号：如 A394		工单内序号：0000~9999	

4.7 其它寄存器/控制位的定义：充电选择寄存器(18H)

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
EN_Charge						Charge1	Charge0
0	-	-	-	-	-	1	1

EN_Charge：0 禁止充电功能;1 允许充电功能（**提示：此模块内置一次性电池，禁止打开充电功能**）；复位值为 0，即禁止充电功能。

Charge1	Charge0	描述
0	0	10k
0	1	5k
1	0	2k
1	1	无穷大，断开。

充电功能开启后，模块电流会增加大约 80uA 左右的 VDD 工作电流，请酌情使用。

WRTC1、WRTC2、WRTC3 位: 寄存器（00H~1FH）写允许位。即 WRTC1=1、WRTC2=1、WRTC3=1 时写允许。注意置位有先后顺序，先置 WRTC1 为 1,后置 WRTC2、WRTC3 为 1;当 WRTC1=0、WRTC2=0、WRTC3=0 时则写禁止，同样置位有先后顺序，先置 WRTC2、WRTC3 为 0,后置 WRTC1 为 0。当写禁止时，除了以上三位可以写以外，从 00H 到 79H 所有的寄存器均不可以写。写禁止并不影响读操作。

特别的:当写允许时,如需要赋值与写保护位相关的寄存器 0FH、10H,则要注意对应的位 WRTC1、WRTC2、WRTC3 的赋值,这三个位只能为 1 而不可为 0,否则会造成写禁止而数据写不进相应的寄存器。又因为 0F 的寄存器其它位均为标志位，所以建议写允许时赋值 0F 寄存器的值可以定为 FFH，写禁止时赋值 0F 寄存器的值可以定为 7BH。

ARST 位: 自动复位使能位.对控制寄存器 1 的 INTAF、INTDF、BAT 位的自动复位进行使能/禁止。

当 ARST=1 时,对控制寄存器 1 进行一次有效的读操作后,以上三个状态位均复位 为"0"。若 ARST=0,则需要对 INTAF、INTDF、BAT 位进行手动复位方可清零。

FOBAT 位:FOBAT=0 时,当处于 VBAT 模式下,INT 脚输出禁止;FOBAT=1 时,当处于 VBAT 模式下,INT 脚输出允许.该位在 VDD 模式下不起作用。(要注意在 VBAT 模式下 INT 脚输出会引起电池的消耗)

RTCF 位:上电位,全部电源失效后再上电则该位置”1”,为只读位.上电后的第一次有效写(只要写一个字节即可)就可以将 RTCF 位清为”0”。

OSF:停振标志位，OSF=1,表示之前有过停振发生。默认值为 0。

BLF:电池电压欠压标志位，当电池电压低于 2.2v 时此位置"1"(不论是 VDD 模式还是 VBAT 模式)。

PMF:电源模式标志位,当电源模式为 VDD 模式时 PMF=0; 当电源模式为 VBAT 模式时 PMF=1。

F32K:32K 输出控制位---32K=0，允许输出；32K=1，禁止输出；默认值为 0。

5.串行 IIC 接口

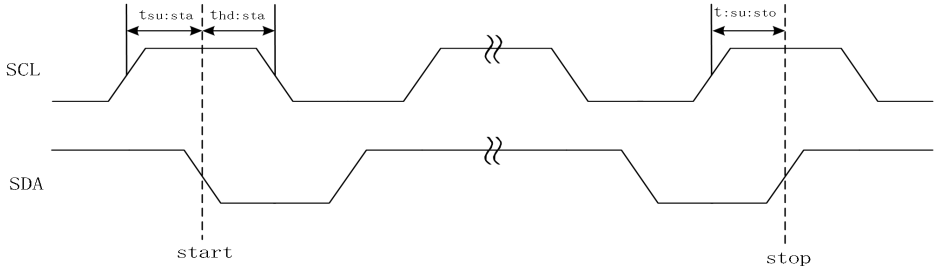
5.1 SD2501 通过两线式 IIC 串行接口方式接收各种命令并读写数据。两线式串行 IIC 接口方式描述如下：

（1）开始条件

当 SCL 处于高电平时，SDA 由高电平变成低电平构成一个开始条件，对 SD2501 的所有操作均必须由开始条件开始。

（2）停止条件

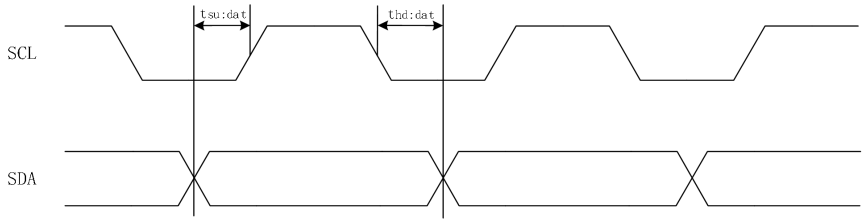
当 SCL 处于高电平时，SDA 由低电平变成高电平构成一个停止条件，对 SD2501 的所有操作均停止，系统进入待机状态。



实时时钟串行接口

（3）数据传输

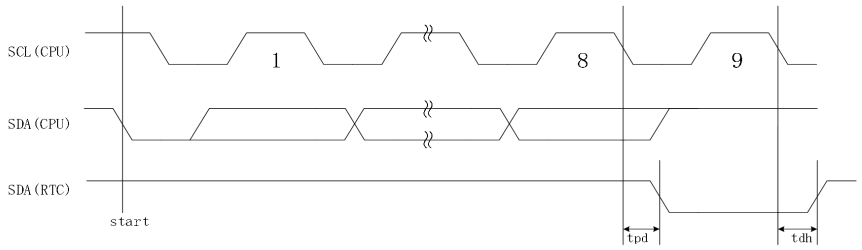
当 SCL 为低电平，且 SDA 线电平变化时，则数据由 CPU 传输给 SD2501（高位在前、低位在后，下同）；当 SCL 为高电平，且 SDA 电平保持不变时，则 CPU 读取 SD2501 发送来的数据：当 SCL 为高电平，且 SDA 电平变化时，SD2501 收到一个开始或停止条件。



实时时钟数据传输时序

（4）确认

数据传输以 8 为序列进行。SD2501 在第九个时钟周期时将 SDA 置位为低电平，即送出一个确认信号（Acknowledge bit，以下简称“ACK”），表明数据已经被其收到。



实时时钟确认信号

5.2 数据/指令传输格式

当 CPU 发出开始条件与实时时钟建立连接后， CPU 首先通过 SDA 总线连续输出 7 位器件地址和 1 位读/写指令来唤醒 SD2501。

(1) 器件代码：

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
0	1	1	0	0	1	0	R/W

其中高 7 位 BIT7~BIT1 称“器件代码”，它代表实时时钟的器件地址，固定为“0110010”;BIT0 为读/写位,”1”为读操作,”0”为写操作。

(2) 数据传输格式

在数据发送/接收时停止信号到来时,将结束其数据传输,同时内部 7 位地址归零(注:内部 7 位地址的缺省值为 00000B)。如果只有开始信号,而没有结束信号,接着重新产生起始信号,则还要重新设置器件代码(在传输方向需要改变时,就用这种传输方式,如下面的读数据方式 1)。

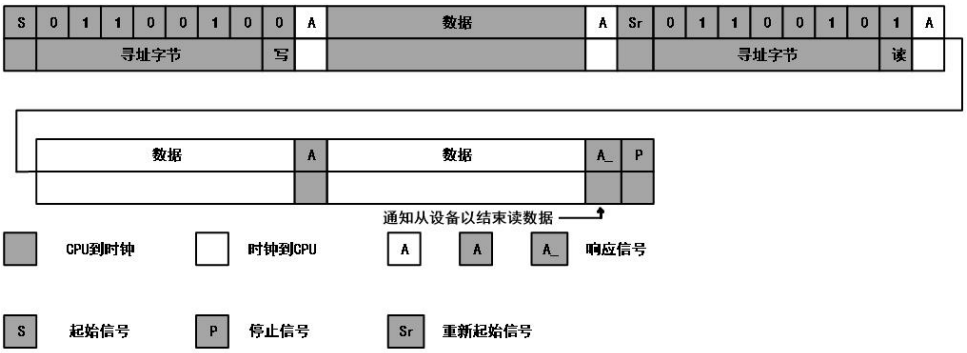
主设备向从设备写入数据过程如下图：

S	0	1	1	0	0	1	0	0	A	数据	A	数据	A	P
	寻址字节							写						

主设备向从设备直接读取数据过程如下图：

S	0	1	1	0	0	1	0	1	A	数据	A	数据	A_	P
	寻址字节							读						

数据传输时改变其传输方向过程图：



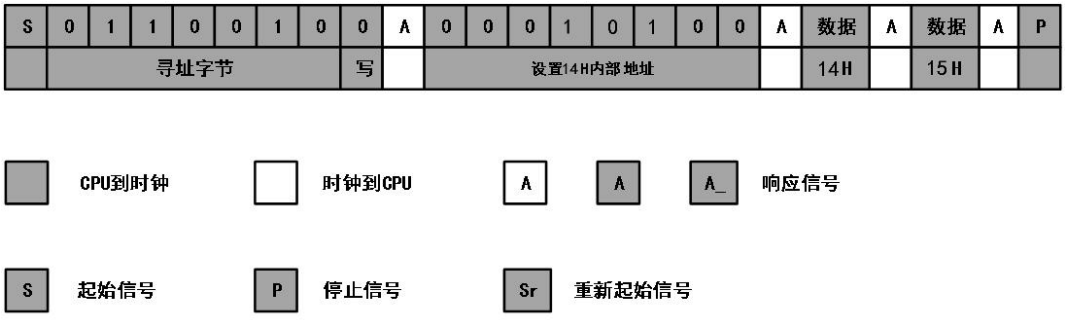
（3）SD2501 数据传输的写模式

先送 7 位器件地址(0110010),第 8 位送入写命令(“0”), 第 9 位是 SD2501 的响应位(ACK),SD2501 进入写状态。

接下来一个字节的 8 位确定 SD2501 的内部地址(00H~79H), , 第 9 位是 SD2501 的响应位。

开始写数据,每写完 1 个字节的数据之后,都经过 1 位的响应信号才能写下 1 字节的数据;如果要结束写数据过程,则在 ACK 后送出停止命令即可。

SD2501 写数据示例(向 14H,15H 地址写数据):



特别注意:

1. 除了 WRTC1、WRTC2、WRTC3 三个写允许位，对寄存器(00H~71H)的写操作必须确认模块处于写允状态,否则写无效。

2. 写时间同步：每次对实时时间秒寄存器的写操作时，当秒数据的 8 个 bit 完全写入并收到 ACK 信号后，就会对秒以下的内部计数器清零，使时间同步。

3. 从当前地址开始,每次读写完一个字节地址自动加 1。

4. 为了提高数据的可靠性，当写完成后，**应将模块置于写禁止状态。**

5. 有关写实时时间数据的位数的特别要求请参见(5.2.注 2)。

（4）SD2501 数据传输的读模式

SD2501 有两种读数据方法:

I)读方法 1:从指定的内部地址中读取数据。

. 与写模式的前两步一样。

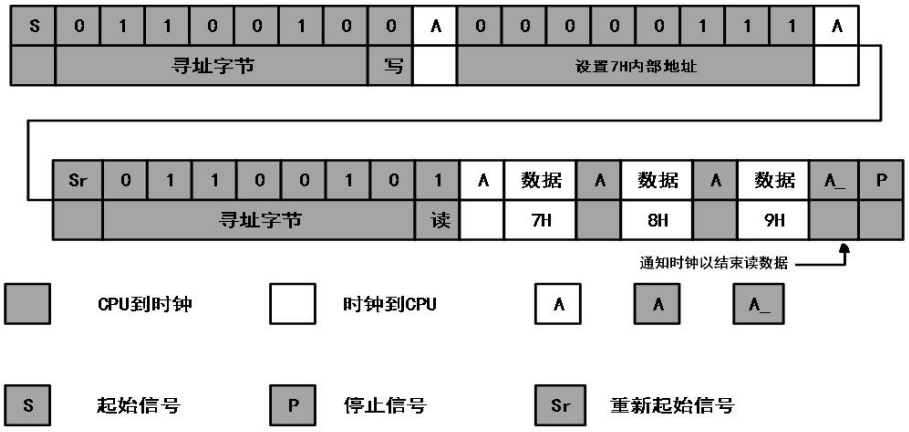
. 重新发出开始命令以改变两线接口数据传输方向。

. 再送 7 位器件地址(0110010),第 8 位送入读命令(“1”), 第 9 位是 SD2501 的响应位

(ACK),SD2501 进入读状态。

. 开始读数据,每读完 1 个字节的数据之后,CPU 都要送出 1 位的响应信号(ACK,低电平)才能读下 1 字节的数据;如果想要结束读数据过程,则 CPU 要送出 1 位的响应信号(ACK_,高电平), ACK_后送出停止命令即可。

SD2501 读数据方法 1 示例(从 7H~9H 地址读取数据):

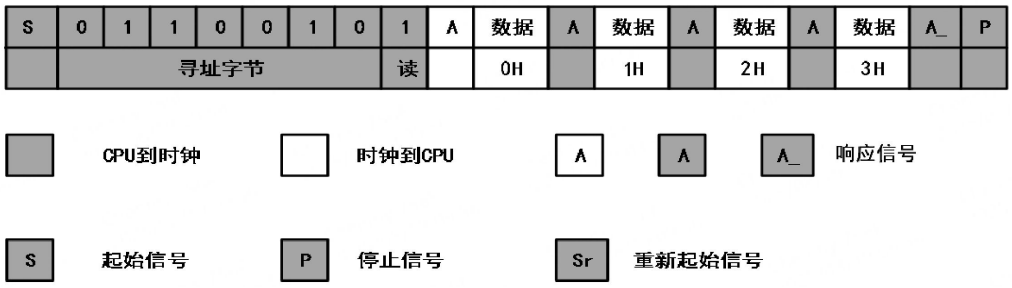


II)读方法 2:直接读取数据(从内部地址 00H 开始)

. 开始信号后,先送 7 位器件地址(0110010),第 8 位送入读命令(“1”), 第 9 位是 SD2501 的响应位(ACK),SD2501 进入读状态。

. 每读完 1 个字节的数据之后,CPU 都要送出 1 位的响应信号(ACK,低电平)才能读下 1 字节的数据;如果想要结束读数据过程,则 CPU 要送出 1 位的响应信号(ACK_,高电平), ACK_后送出停止命令即可。

SD2501 读数据方法 2 示例(从 00H 地址开始读取数据):



（5）SD2501 在特殊条件下的数据传输

为了保证读写数据的有效性,SD2501 的两线通信开始到结束仅在此 0.5S 秒之内,如此可避免总线挂死的现象。

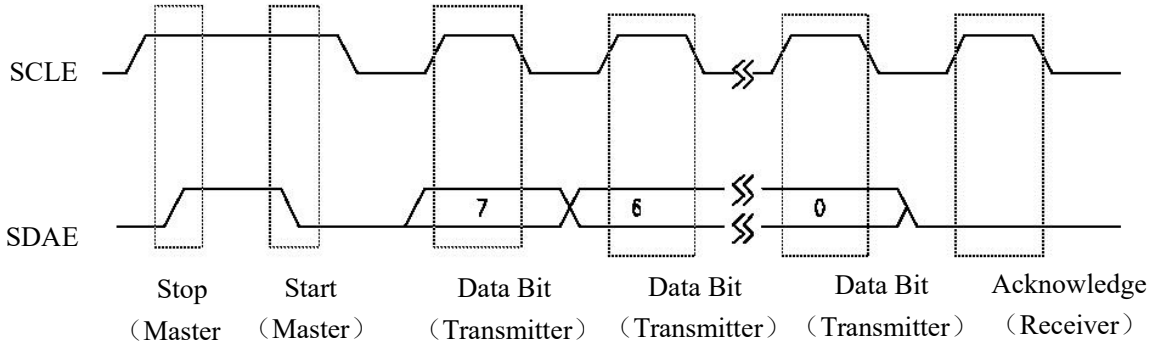
因此在 SD2501 中,IIC 通信方式会在第一个开始信号（START)到来之后的 0.5 秒之内自动终止本次通信。所以,要注意: 从开始信号进行读/写数据,直到停止信号, 读/写操作过程必须在 0.5 秒之内完成。

6. 串行 NVSRAM 电路（适用于 SD2501 RAM 系列中的 C/D/E/G 型）

1.SRAM 数据传输协议(I2C 接口)

(1)开始条件/(2) 停止条件/(3)数据传输/(4)应答信号（Acknowledge bit）

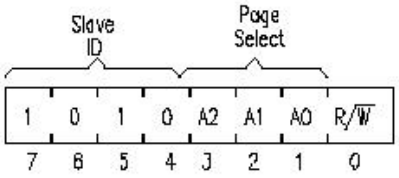
如下图所示，以 SCLE 对应 SCL，以 SDAE 对应 SDA，参照本文有关实时时钟串行接口部分的描述。



SRAM 数据传输

2.操作指令

当 CPU 要对 SD2501 中的 SRAM 进行操作时，首先发出开始信号给 SD2501，然后 CPU 发出包括四位器件代码（固定为“1010”）、三位页地址、一位操作码（读操作为“1”，写操作为“0”）的八位数据，即为“从器件地址”（SLAVE ADDRESS）。



这八位从器件地址数据中三位页地址根据 SD2501 具体的型号而有所不同：

（1）当为 C 型 SD2501 时，该三位均为页选码（SRAM 对数据的操作分为八页进行，每页的地址为 00—FFH）。

（2）当为 D 型 SD2501 时，该三位被固定为“000”。

（3）当为 E 型 SD2501 时，该三位被固定为“000”。

（4）当为 G 型 SD2501 时，该三位在低 256Kbit 时被固定为“000”，在高 256Kbit 时被固定为“001”。

表 8　SRAM 操作指令

型号	器件代码	三位页地址	操作码	页内范围
C 型	1010	000～111	读“1”写“0”	00~FFH
D 型	1010	000	读“1”写“0”	0000~1FFFH
E 型	1010	000	读“1”写“0”	0000~7FFFH
G 型	1010	000	读“1”写“0”	0000~7FFFH
		001		0000~7FFFH

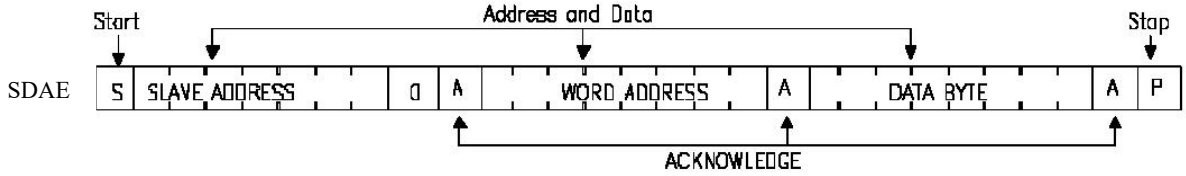
3.写操作

写操作可分为两种，单字节写操作和连续写入操作。单字节写操作指每次只写入一个字节的数据。连续写入操作指可以写入任意数量字节的数据。由于内置 NVSRAM 的存储容量的大小不同，因此在进行写操作时，其操作方式有所不同。

（1）单字节写操作

A）C 型 SD2501 单字节写操作

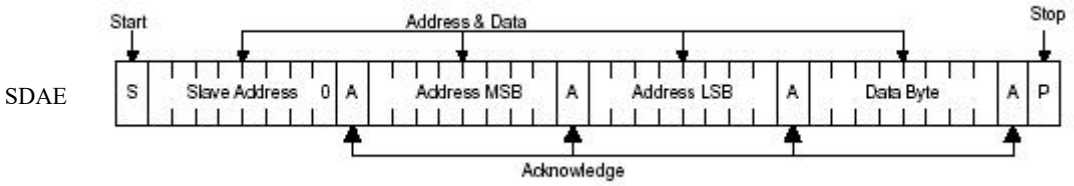
在单字节写操作下，主器件发送起始信号和从器件地址信息（$\overline{R}$/W 位置 0） 给从器件。在从器件送回应答信号后，主器件发送一个 8 位地址字写入 SRAM 的地址计数器。主器件在收到 SRAM 的应答信号后再发送数据到被寻址的存储单元，SRAM 再次应答并在主器件产生停止信号后开始内部数据的擦写(内部擦写周期小于 300ns)。在内部擦写过程中，SRAM 不再应答主器件的任何请求。



C 型 SD2501 SRAM 单字写操作

B) D 型、E 型和 G 型 SD2501 单字节写操作

在单字节写操作下，主器件发送起始信号和从器件地址信息（R/W 位置 0） 给从器件。在从器件送回应答信号后，主器件首先发送高八位地址给 SRAM， SRAM 再次应答后主器件发送低八位地址给 SRAM，主器件在收到 SRAM 的应答信号后再发送数据到被寻址的存储单元，SRAM 再次应答并在主器件产生停止信号后开始内部数据的擦写。在内部擦写过程中，SRAM 不再应答主器件的任何请求。

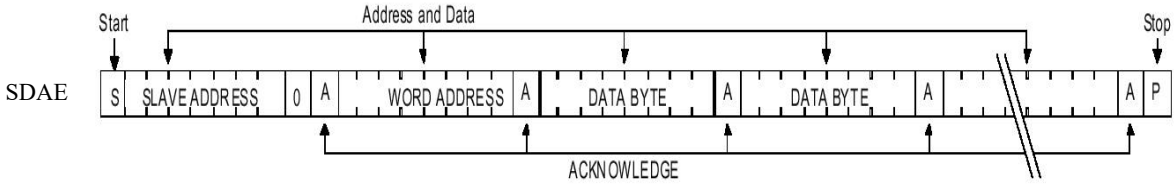


D 型、E 型和 G 型 SD2501 SRAM 单字写操作

（2）连续写入操作

A) C 型 SD2501 连续写入操作

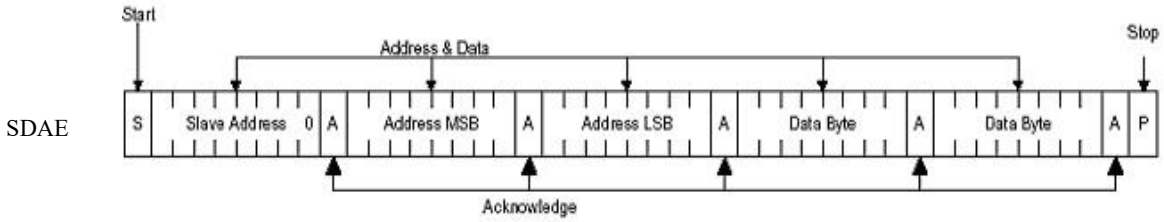
在连续写入操作下,单个写周期内 SRAM 可以被写入任意数量的数据。连续写入操作的启动与该型号的单字节写操作一样，区别在于传送了一字节数据后允许主器件继续发送 n 个字节的数据。每传送完一个字节数据后，SRAM 响应一个应答信号且内部地址计数器（共 9 位或 11 位）自动加 1。若地址计数器的值到达边界时，该值将从 7FFH 变为 000H(C 型)。



C 型 SD2501 SRAM 连续写入操作

B) D 型、E 型和 G 型 SD2501 的连续写入操作

在连续写入操作下,单个写周期内 SRAM 可以被写入任意数量的数据。连续写入操作的启动与该型号的单字节写操作一样，区别在于传送了一字节数据后允许主器件继续发送 n 个字节的数据。每传送完一个字节数据后，SRAM 响应一个应答信号且内部地址计数器（共 16 位）自动加 1。若地址计数器的值到达边界时，该值将从 1FFFH 变为 0000H(D 型)或从 7FFFH 变为 0000H(E、G 型)。



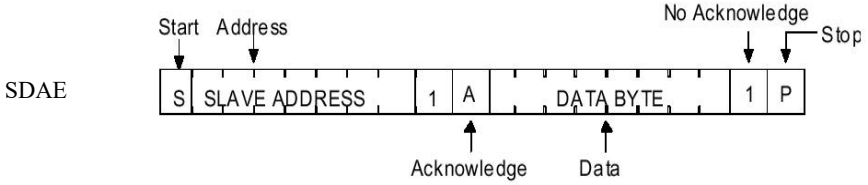
D 型、E 型和 G 型 SD2501 SRAM 连续写入操作

4.读操作

除读/写位被设定为“1”外，CPU 以与写操作同样的方式初始化读操作。读操作有三种方式：立即地址读操作，随机地址读操作，连续读操作。同样由于内置 NVSRAM 的存储容量的大小不同，因此在进行读操作时，其操作方式有所不同。

（1）立即地址读操作

C 型、D 型、E 型、G 型这四种型号的立即地址读操作的形式是一样的。SRAM 的地址计数器内容为最后操作字节的地址加 1， 也就是说如果上次读/写的操作地址为 N，则立即读的地址从地址 N+1 开始。如果 N 为边界值(分别为 7FFH,1FFFH,7FFFH,7FFFH)，则寄存器将会翻转到地址 0 继续输出数据。在 SRAM 接收到从器件地址以后（R/W=1）， 它首先发送一个应答信号，然后发送一个 8 位字节数据。主器件不需要发送一个应答信号，但是要产生一个停止信号。

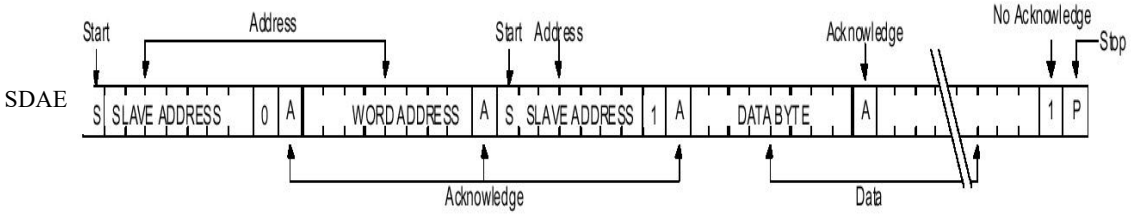


SRAM 读当前地址操作

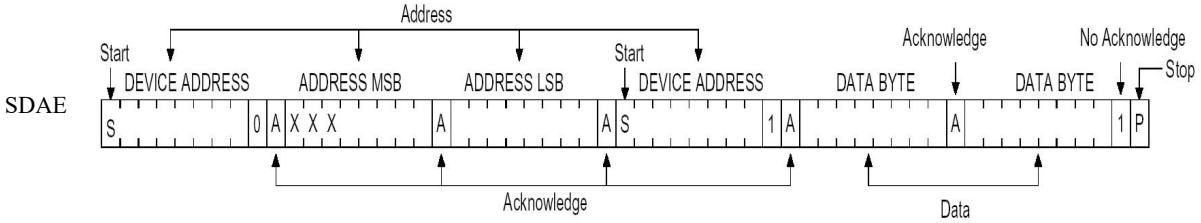
（2）随机地址读操作

随机读操作允许主器件对寄存器的任意字节进行读操作。主器件首先通过发送起始信

号、从器件地址和它想读取的字节数据的地址（B 型和 C 型为单字节地址，而 D 型和 E 型为双字节地址）给 SRAM（此时 R/W 位置为 0）。在 SRAM 应答之后，主器件重新发送起始信号和从器件地址（此时 R/W 位置为 1），SRAM 响应并发送应答信号，然后输出所要求的一个 8 位字节数据，主器件不发送应答信号但要产生一个停止信号。



C 型 SD2501 的 SRAM 随机地址读操作

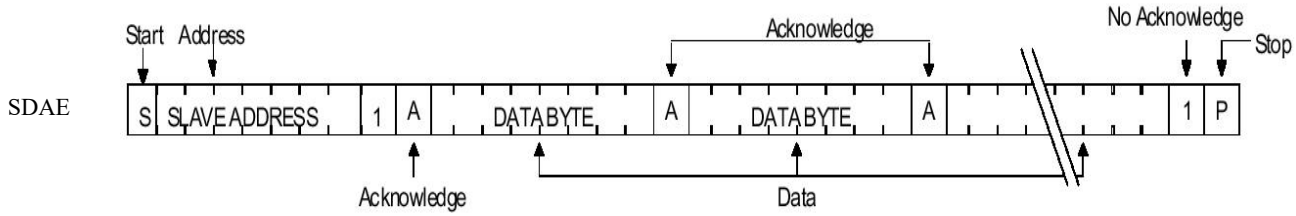


D 型、E 型和 G 型 SD2501 的 SRAM 随机地址读操作

5.连续读操作

C 型、D 型、、E 型和 G 型这四种型号的连续地址读操作的形式也是一样的。连续读操作可通过立即读或选择性读操作方式启动。在 SRAM 发送完第一个 8 位字节数据后，主器件产生一个应答信号来响应，告知 SRAM 主器件要求更多的数据。对应每个主器件产生的应答信号 SRAM 将发送一个 8 位数据字节。当主器件不发送应答信号而发送停止信号时结束此操作。

从 SRAM 输出的数据按顺序由 N 到 N+1 输出。读操作时的地址计数器在 SRAM 整个寄存器区域增加，这样整个寄存器区域可在一个读操作内全部读出。若地址计数器的值到达边界时，该值将从(分别为 7FFH,1FFFH,7FFFH,7FFFH)变为 000 或 0000H。



SRAM 连续读操作

7. 出厂设置

在出厂之前，对 SD2501 已做了时间和控制寄存器初始化设置：

时间为北京标准时间，禁止 INT 脚输出信号，数字调整寄存器初值。

实时寄存器：当前的北京时间，xx（年），xx（月），xx（日），x（星期），xx（时），xx（分），x（秒）

8．电源管理电路

1.内部电源管理电路(电源切换电路)1 内部电源管理电路(电源切换电路)

当 VDD>2.4V 时，则内部电池停止供电，改由外部 VDD 供电。在外部电源掉电情况下，内部电池保证时钟继续可靠运行，内置充电电池使用寿命 5~8 年， 当电池能量耗尽后，可通过 VBAT 引脚采用备份电源供电，并可以通过 TEST 引脚测量电池电压。

特别地：对内置充电电池的时钟模块不上电充电时间不能超过一年，不要等电池的电耗光后再去充电，否则会减少电池的使用寿命。

2．稳压电路

模块内部有稳压电路，可以对外加电源电压进行滤波、稳压，使模块工作始终工作在稳定状态。

3. 电源失效检测

SD2501 有一个实时时钟失效位（RTCF），用于检测总电源失效。它在器件丢失所有电源（VDD 和后备电池）之后使用户可以确定器件是否已上电。

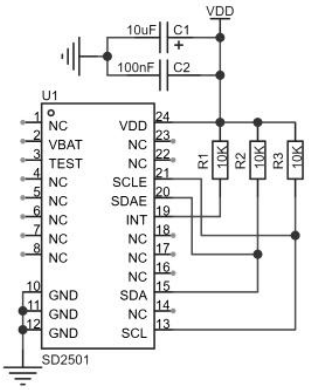
9．使用说明

1.为了防止电路噪声问题,请在此模块的旁边放置 0.1uF 旁路电容。

2.为了防止干扰,在 PCB 制作时请保证模块底部无大电流信号通过,最好能铺地。

10. 应用电路与程序

（1）应用电路:



SD2501 型应用电路图

(2)程序下载网址：http://www.whwave.com.cn/download/SD2501/SD2501ALL.asp

11．极限参数

VDD 、SCL、SDA、SCLE、SDAE 和 INT 引脚上的电压（相对于地）…… －0.5V 至 7.0V

引线温度（焊接,10 秒） …… 260℃

注：强度超出所列的极限参数可能导致器件的永久性损坏。这些仅仅是极限参数，并不意味着在极限条件下或在任何其它超出推荐工作条件所示参数的情况下器件能有效地工作。延长在极限参数条件上的工作时间会影响器件的可靠性。

12. 直流特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DD}	主电源		3.3		5.5	V
V_{BAT}	电池供电电压		2.3		3.6	V
I_{DD1}	电源电流	V_{DD}=5V		1.6	3.0	μA
		V_{DD}=3V		1.0	1.2	μA
I_{DD2}	IIC 通信时的电源电流	V_{DD}=5V		40	120	μA
I_{BAT}	电池供电电流	V_{BAT}=3V		700		nA
I_{LI}	SCL 的输入漏电流			100		nA
I_{LO}	SDA 上的 I/O 泄漏电流			100		nA
V_{BATHYS}	VBAT 和 VDD 之间切换的迟滞电压			300		mV
INT/SDA V_{OL}	INT/SDA 低电平输出电压	V_{DD}=5V I_{OL}=3mA		0.4		V

13. 掉电时序(温度:－30℃至+80℃)

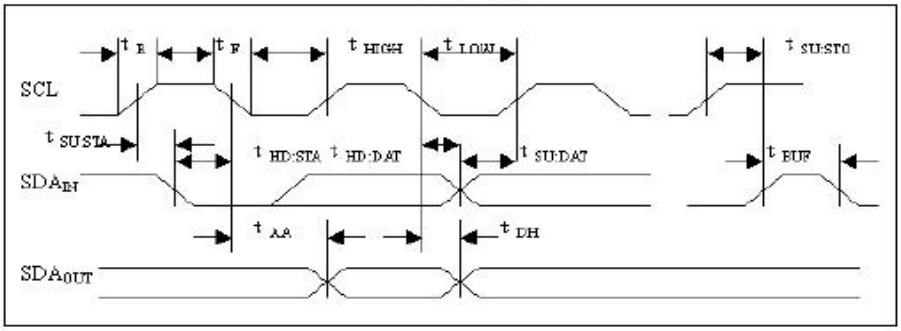
符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位	注意
$V_{DD\,br}$	V_{DD} 下电速率				10	V/ms	

14. 交流特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IL}	SDA 和 SCL 低电平输入电压		-0.3		0.3×V_{DD}	V
V_{IH}	SDA 和 SCL 高电平输入电压		0.7×V_{DD}		V_{DD}+0.3	V
Vhys	SDA 和 SCL 施密特触发输入滞后		0.05×V_{DD}			V
V_{OL}	低电平输出电压	SDA 输出低电平状态下，吸收 2mA 电流时的电压	0		0.4	V
C_{pin}	SDA 和 SCL 引脚电容	T_A=25℃ f=1MHz V_{DD}=5V V_{IN}=0V V_{OUT}=0V			10	pF

f_{SCL}	SCL 频率				400	
t_{IN}	SDA 和 SCL 输入端的脉冲宽度抑制时间				50	ns
t_{AA}	SCL 下降沿到 SDA 输出数据有效	SCL 下降到 0.3×V_{DD}，直到 SDA 不在 0.3×V_{DD} 至 0.7×V_{DD} 区间。			900	ns
t_{BUF}	总线在 STOP 和 START 之间的空闲时间	SDA 在 STOP 条件下上升到 0.7×V_{DD}，在开始条件下下降到 0.7×V_{DD}。	1300			ns
t_{LOW}	时钟低电平时间	在 0.3×V_{DD} 处测量	1300			ns
t_{HIGH}	时钟高电平时间	在 0.7×V_{DD} 处测量	600			ns
$t_{SU:STA}$	IIC 启动信号的建立时间	SCL 上升到 0.7×V_{DD} 至 SDA 下降沿到 0.7×V_{DD}	600			ns
$t_{HD:STA}$	IIC 停止信号的保持时间	在 SDA 下降沿到 0.3×V_{DD}，SCL 下降沿到 0.7×V_{DD}	600			ns
$t_{SU:DAT}$	输入数据的建立时间	从 SDA 不在 0.3×V_{DD} 至 0.7×V_{DD} 范围，到 SCL 上升沿的 0.3×V_{DD}	100			ns
$t_{HD:DAT}$	输入数据保持时间	SCL 下降沿的 0.3×V_{DD}，到 SDA 在 0.3×V_{DD} 至 0.7×V_{DD} 区间	0		900	ns
$t_{SU:STO}$	停止条件的建立时间	从 SCL 上升沿经过 0.7×V_{DD}，到 SDA 上升沿 0.3×V_{DD}	600			ns
$t_{HD:STO}$	输出条件的保持时间	从 SDA 上升沿到 SCL 下降沿。两者均超过 VDD 的 70%。	600			ns
t_{DH}	数据输出的保持时间	从 SCL 下降沿 0.7×V_{DD}，到 SDA 0.3×V_{DDD} 至 0.7×V_{DD} 区间	0			ns
t_R	SDA 和 SCL 的上升时间	0.3×V_{DD} 至 0.7×V_{DD} 区间	20+0.1×Cb		300	ns
t_F	SDA 和 SCL 的下降时间	0.3×V_{DD} 至 0.7×V_{DD} 区间	20+0.1×Cb		300	ns
Cb	SDA 或 SCL 的容性负载	片内和片外合计	10		400	PF
R_{PU}	片外 SDA 和 SCL 总线上拉电阻	最大值由 t_R 和 t_F 确定， 当 Cb=400pF 时，最大值约为 2~2.5kΩ 当 Cb=40pF 时，最大值约为 15~20kΩ。	1			kΩ

总线时序图



15. 串行 NVSRAM 部分电气特性：

（1）直流电气特性(TA =－30℃～+80℃, VDD = 3.3Vto5.5V)

符号	参数	最小值	最小值	最大值	单位	备注
V_{DD}	主电源	3.3	5.0	5.5	V	1
I_{DD}	V_{DD} 供电电流(@SCLE=100KHz)		115	150	μA	2
I_{DD}	V_{DD} 供电电流(@SCLE=400KHz)		400	500	μA	2
I_{SB}	休眠电流		1	10	μA	3
I_{LI}	输入漏电流			10	μA	4
I_{LO}	输出漏电流			10	μA	4
V_{IL}	输入低电压	-0.3		V_{DD}×0.3	V	5
V_{IH}	输入高电压	V_{DD}×0.7		V_{DD}+0.5	V	5
V_{OL}	输出低电压(@I_{OL}=3mA)			0.4	V	1.5
V_{OL}	输出低电压(@I_{OL}=6mA)			0.6	V	1.5
V_{HYS}	输入滞后	V_{DD}×0.5			V	1.5

备注：1. 参考电压 VSS。

2. SCL 在 VDD－0.3V 和 VSS 之间触发，其它输入为 VSS 或 VDD－0.3V。

3. SCL=SDA=VDD. 所有输入为 VSS 或 VDD。停止命令被发送。

4. VIN 或 VOUT=VSS～VDD。

5. 此参数是经抽样而非 100%测试得到的。

（2）交流电气特性(TA =－30℃～+80℃, VDD = 3.3Vto5.5V)

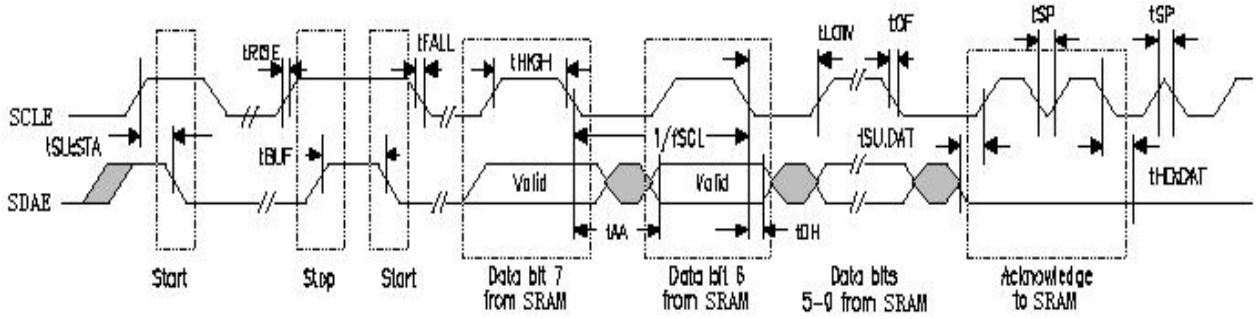
符号	参数	标准模式		快速模式		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	
fSCLE	SCLE 时钟频率	0	100	0	400	KHz
tSP	噪音抑制时间(SCLE,SDAE 保持稳定)		50		50	ns
tAA	SCLE 低电平到 SDAE 输出有效		3		0.9	μs
tBUF	在新传输前释放总线	4.7		1.3		μs
tHD:STA	开始条件保持时间	4.0		0.6		μs
tLOW	时钟低电平时间	4.7		1.3		μs
tHIGH	时钟高电平时间	4.0		0.6		μs
tSU:STA	开始条件设定时间	4.7		0.6		μs
tHD:DAT	数据输入保持	0		0		ns
tSU:DAT	数据输入设定	250		100		ns
tRISE	SDAE,SCLE 上升时间。		1000	20+0.1cb	300	
tFALL	SDAE,SCLE 下降时间。		300	20+0.1cb	300	ns
tSU:STO	停止条件设定	4.0		0.6		μs
tDH	数据输出保持(从 SCLE@VIL)	0		0		ns
tOF	输出下降时间(VIN 从最小到最大)		250	20+0.1cb	250	ns

符号	参数	最大值	单位
CI/O	输入/输出电容（SDAE）	8	pF
CIN	输入电容	6	pF

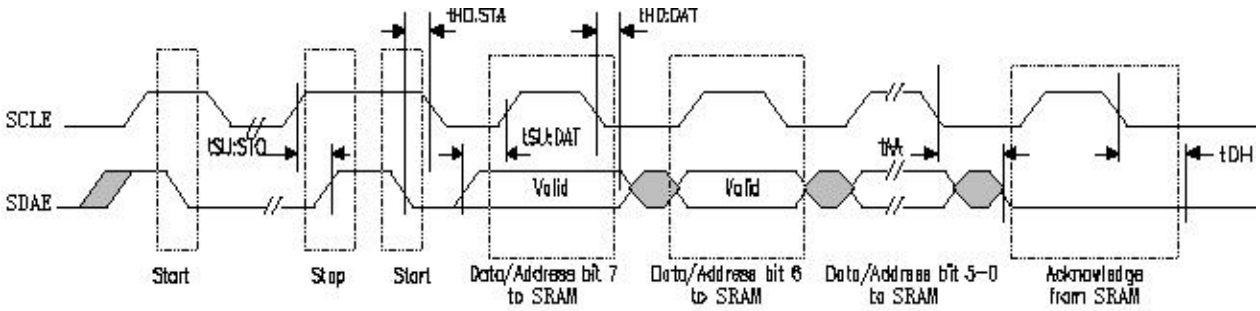
注意：

1. Cb=一条总线上的总电容数（以 pF 为单位）。

2. 开始和停止条件时序参数都应用在读和写电路中。对于读和写电路来说时钟规范是相同的。对于表中的各参数，请参照下面的时序图。

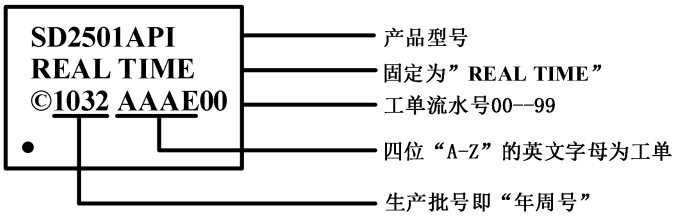


SRAM 读总线时序

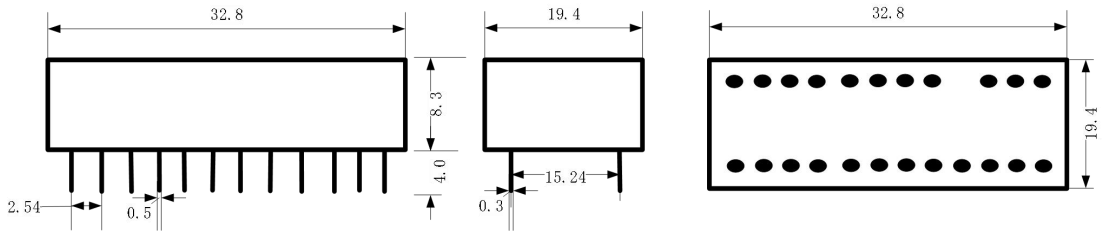


SRAM 写总线时序

16. 模块顶部字符说明



17. 封装尺寸（DIP24, 单位:mm;尺寸误差±0.3mm, 特别说明除外。）



SD2501 系列封装尺寸（管脚尺寸：0.5*0.3mm，管脚公差±0.05mm）

■ 编后语

感谢您阅读本资料。由于经验和水平的欠缺，本文难免有错误和遗漏。如果您在使用过程中发现错误或不恰当的地方，请拨打电话：0755-83246178 或请 E-mail：support@whwave.com.cn,我们将尽快予以答复。

谢谢您的支持与合作！

注：

本资料中的内容如有变化，恕不另行通知。

本资料提供的应用线路及程序仅供参考，本公司不承担由此而引起的任何损失。

由于本公司的产品不断更新和提高,希望您经常与本公司联系，以索取最新资料。

本公司不承担在任何使用过程中引起的侵犯第三方专利和其它权利的责任。

注：本文档受中国版权法保护,非授权禁止拷贝、复制、引用或传播

（SD 及 WAVE 均为我公司注册商标）

深圳市兴威帆电子技术有限公司

版本号	修改时间	修改记录	修改人
V2.3	2025.08.27	修改倒计时部分	CHENMY
V2.4	2026.02.05	修改封装尺寸部分	CHENMY

附录:

一.SD2501 系列应用中硬件注意事项:

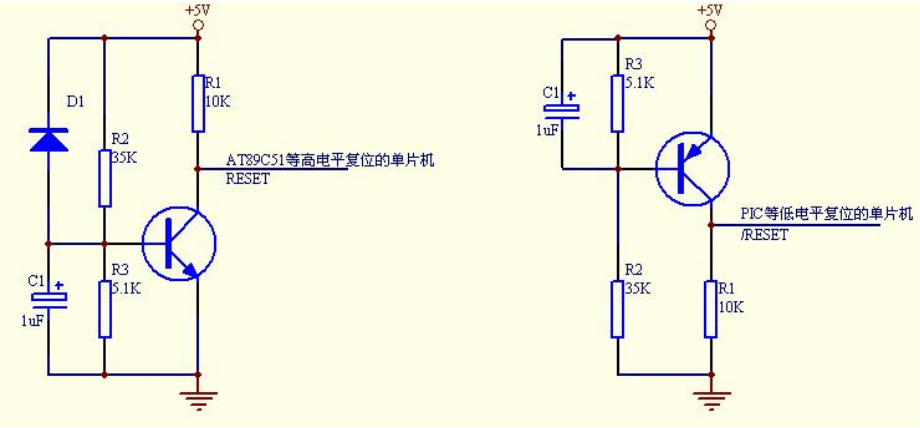
(1) 对 SD2501 及 MCU 的电源~地之间加 104 电容去高频。

(2) 对 SD2501 及 MCU 所在的板数字电源~地的输入端加 220uF 以上的电解及 104 电容去除电源扰动.

(3) 为了防止干扰, 在 PCB 制作时请保证模块底部无大电流信号通过, 最好能铺地.

(4) 对 SD2501,在 VDD 和电源之间串一个 **100** 欧的电阻防干扰.

(5) 对 MCU 的复位端尽量采用可靠的复位方式,而摒弃阻容复位或直接连到 VDD 的方式.以下推荐廉价的三极管复位方式,当然用电压检测器或专用复位电路就更好啦.



图中 R2,R3 为分压电阻,其选值可用以下公式:

Vbe/Vrst=R2/(R2+R3)

其中:Vbe 为三极管 b 极和 e 极之间导通电压

Vrst 为单片机的复位电压

C1 为延时电容

D1 为延时电容的放电二极管,可选用.

(6) SD2501 不用的脚接地(VBAT.VOUT.INT 和 TEST 脚除外).

二.SD2501 系列应用中软件注意事项

(1) 软件上电开始做一个几百毫秒的延时，等 MCU 端口稳定后再去进行读写操作。

(2) 时钟最多半秒才读一次：这样做主要目的是考虑到时间数据的改变需要 1S，频繁去读的话是在做无用功，不但会加大电源功耗，而且会引入干扰。

IIC 总线"START"里:在置 SDA 为高后要再判断 SDA 是否为高,即 SDA 是否被箝位为低,否则等 SDA 线置高。.

在写命令字时:要判断 ACK 是否正常,否则退出

(3) IIC 总线"STOP"里:在置 SDA 为高后要再判断 SDA 是否为高,即 SDA 是否被箝位为低,否则多置 SCL 脉冲让 SDA 线释放为高.在写命令字时:要判断 ACK 是否正常,否则退出，不要再进行下面的操作。

(4) 写时间时，最好能对时间调整寄存器(12H)清零,在网上有 51 程序可参考。

三.有关 SD2501 的一些问题回答

(1) 时钟精度:

SD2501 的精度指标为常温 25 度下±5ppm,即年误差少于 2.6 分钟.

出厂之前对每一只 SD2501 都用超高精度的仪器和严格的程序做了校准,所以能保证精度.有人说他拿到 SD2501 的精度好像不准,一般问题出在参考时钟上,通常可用电信 12117 台作基准来验证,但如用电脑那就差远了,因为电脑的时钟精度一般都不高,通常大于 30ppm.最好用网络校时软件.

最好用网络校时软件.

电脑版校时软件：

http://www.whwave.com.cn/download/wave/AboutTime.rar

手机安卓版网络/GPS 校时软件：

http://zhushou.360.cn/detail/index/soft_id/3179034?from=onebox

(2) 温度对精度的影响:

SD2501 系列时钟均含有温度补偿。